

Verwendung: Mittelschneller Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Schalttransistor für die Verwendung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen bei Umgebungstemperaturen θ_a von -40°C bis $+125^\circ\text{C}$

Abmessungen: Bauform B 3/25 – 3a,

TGL 11 811

Kollektor am Gehäuse

Masse ≈ 1 g

Zulässige Höchstwerte gültig bis $\theta_{j\text{max}}$

$U_{CB0} = 60$ V $P_{\text{tot}} = 600$ mW

$U_{CE0} = 50$ V bei $\theta_a = 25^\circ\text{C}$

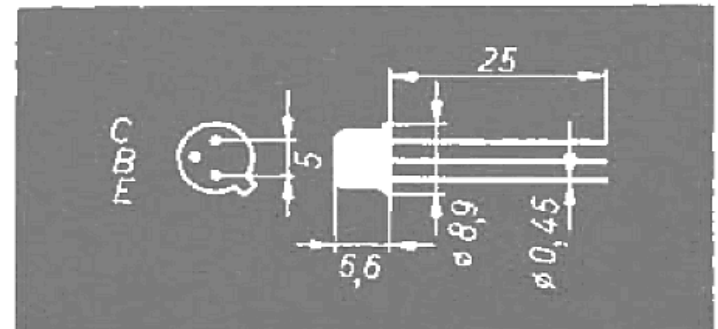
$U_{EB0} = 5$ V $P_{\text{tot}} = 2,5$ W

$I_c = 500$ mA bei $\theta_j = 25^\circ\text{C}$

bei $t_{\text{av}} = 20$ ms $\theta_j = 175^\circ\text{C}$

$\hat{I}_c = 700$ mA $\theta_a = 125^\circ\text{C}$

$I_B = 250$ mA



Wärmewiderstand $R_{\text{thja}} \leq 250 \frac{\text{grad}}{\text{W}}$

$R_{\text{thjc}} \leq 60 \frac{\text{grad}}{\text{W}}$

Kennwerte für $\theta_a = 25^\circ\text{C} -5$ grad

	Min.	Typ	Max.	Meßbedingungen	Stromverstärkungsgruppen
Restströme					
I_{CB0}			25 nA	$U_{CB} = 40$ V	
Kollektor-Basis-Spannung					
U_{CB0}	60 V			$I_c = 5 \mu\text{A}$	
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung					
$U_{(BR) CE0}$	50 V			$I_c = 50$ mA	
Emitter-Basis-Spannung					
U_{EB}	5 V			$I_E = 5 \mu\text{A}$	
Gleichstromverstärkung					
B	18 29 45		35 55 88	$U_{CE} = 1$ V, $I_c = 400$ mA (Messung erfolgt impulsmäßig)	A B C
Übergangsfrequenz					
f_T	30 MHz			$U_{CE} = 12$ V, $I_c = 50$ mA $f = 15$ MHz	

Bestellbeispiel für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe B

Transistor SS 126 B